

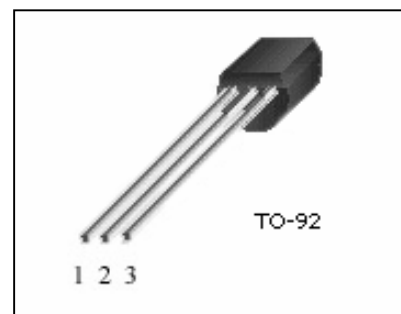
КП511А,Б

КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО ПЛАНАРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ

АДБК 432140.111 ТУ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫСОКОВОЛЬНЫХ ДРАЙВЕРАХ, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ НАПРЯЖЕНИЯ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ АНАЛОГОВЫХ СХЕМАХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ.

- Зарубежный аналог – **КП511А-ТН0535**
КП511Б-ТН0540
- * Изготавливается в корпусе **КТ-26 (ТО-92)**.



1 - Исток 2 – Сток 3 – Затвор

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. изм	Значение
Напряжение сток-исток	Уси max	В	350
	КП511А КП511Б		400
Напряжение затвор-исток	Узи max	В	±20
Постоянный ток стока	Iс max	А	0,14
Импульсный ток стока	Iс и max	А	0,75
Рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	0,75
Температура перехода	Tпер	°С	150

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Токр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измерения	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение	Узи пор	В	Iс=1мА, Узи=Уси ti≤300мкс. Q ≥50	0.8	2.0
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии	Rси отк	Ом	ti≤300мкс. Q ≥50		
			Iс=100мА, Узи=4,5В	-	22
			Iс=150мА, Узи=10В	-	22
Остаточный ток стока	Iс ост	мкА	Уси=Уси max, Узи=0	-	10
Ток утечки затвора	Iз ут	нА	Уси=0, Узи= ±20В	-	100
Крутизна ВАХ	S	А/В	ti≤300мкс. Q ≥50	0,125	-
			Уси =25В, Iс=100мА		
Прямое напряжение на диоде	Uпр	В	ti≤300мкс. Q ≥50 Узи=0, Iс= -150мА	-	1,2
Время включения	* твкл	нс	Iс= 250мА Уси=25В, Rг=25 Ом	-	16
Время выключения	* твыкл	нс	Iс=250мА Уси=25В, Rг=25 Ом	-	17
Входная емкость	* C11и	пФ	Узи=0, Уси=25В, f=1МГц	-	60
Выходная емкость	* C22и	пФ	Узи=0, Уси=25В, f=1МГц	-	15
Проходная емкость	* C12и	пФ	Узи=0, Уси=25В, f=1МГц	-	8

- Справочные параметры

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"

Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>